

肖特基势垒混频二极管主要电特性参数 (T_A=25℃)

参数名称	正向电压	正向电压差值	击穿电压	正向微分电阻	变频损耗	噪声比	整机噪声系数	整流电流	中频阻抗	电压驻波比	封装类型	
符号	V _F	ΔV _F	V _(BR)	r _F	L _c	N _r	NF	I _o	Z _{if}	VSWR	—	
测试条件	I _F =1mA	I _{F1} =1mA I _{F2} =0.3mA	I _R =10μA	I _F =20mA f=50Hz	WH1001: f=16GHz, P _i =1.5mW, R _i =400Ω, R _v =100Ω, f _{if} =30MHz WH1003: f=9.375GHz, P _i =1.8mW, R _i =400Ω, R _v =100Ω, f _{if} =30MHz WH513: f=16GHz, P _i =1.8mW, R _i =400Ω, R _v =100Ω, f _{if} =180MHz							—
单位	mV	mV	V	Ω	dB	—	dB	mA	Ω	—	—	
极限值 型号	最大	最大	最小	最大	最大	最大	最大	最小	最小	最大	最大	—
WH1001	280	60	2.0	40	6.0	1.2	8.0	1.0	260	600	1.5 (typ)	T1810
WH1001A	280	60	2.0	40	6.0	1.2	8.0	1.0	260	600	1.5 (typ)	T2011
WH1003	200~325	45	2.0	18	4.5	1.1	6.0	1.0	200	600	—	W205
WH5131	500~690	40	4	3.0	3.8	1.1	5.3	1.3	280	600	1.8	W121
WH5132	500~690	40	4	3.0	3.5	0.98	4.8	1.3	280	600	1.8	
WH5133	500~690	50	4	6.0	3.8	1.1	5.3	1.3	280	600	1.8	

注: N_r=L_c(N_F+N_{if}-1), N_{if}中放噪声系数为 1.5dB。

肖特基势垒混频二极管芯片主要电特性参数 (T_A=25℃)

参数名称	正向电压	正向电压差值	击穿电压	正向微分电阻	反向电流	结电容	噪声系数	封装类型
符号	V _F	ΔV _F	V _(BR)	r _F	I _R	C _j	NF	—
测试条件	I _F =1mA	I _{F1} =1mA I _{F2} =0.3mA	I _R =10μA	I _F =20mA f=5KHz	V _R =2V	V _R =0V f=1MHz	NF _{if} =1.5dB, P _{in} =1.0mW, f _{if} =30MHz, f=3GHz	—
单位	mV	mV	V	Ω	μA	pF	dB	—
极限值 型号	最大	最大	最小	最大	最大	最大	最大	—
WH1004	280	45	2.0	15	10	0.60	6.5@f=3GHz	芯片
WH1005	300	45	2.0	15	10	0.45	6.5@f=6GHz	
WH1006	320	45	2.0	15	10	0.18	7.0@f=9.375GHz	
WH1007	330	47	2.0	18	10	0.15	7.5@f=16GHz	
WH1008	350	50	2.0	20	10	0.10	8.5@f=24GHz	
WH1009	400	45	3.0	15	—	0.60	6.5@f=3GHz	
WH1010	430	45	3.0	15	—	0.18	7.0@f=9.375GHz	
WH1011	440	47	3.0	18	—	0.15	7.5@f=16GHz	
WH1012	450	50	3.0	20	—	0.10	8.5@f=24GHz	

肖特基势垒检波二极管主要电特性参数 (T_A=25℃)

参数名称	正向电压	正向电压差值	正向微分电阻	反向电流	电压灵敏度	正切灵敏度	封装类型
符号	V _F	ΔV _F	r _F	I _R	β	T _{SS}	—
测试条件	I _F =1mA	I _{F1} =1mA I _{F2} =0.3mA	I _F =10mA f=5KHz	V _R =1V	f=9.375GHz P _{in} =-40dBm	f=9.375GHz Δf=3MHz	—
单位	mV	mV	Ω	μA	mV/mW	dBm	—
极限值 型号	最小	最大	最大	最大	最小	最大	—
WJ3022A	—	300	60	40	20	2000@f=16GHz -50@f=16GHz	W205